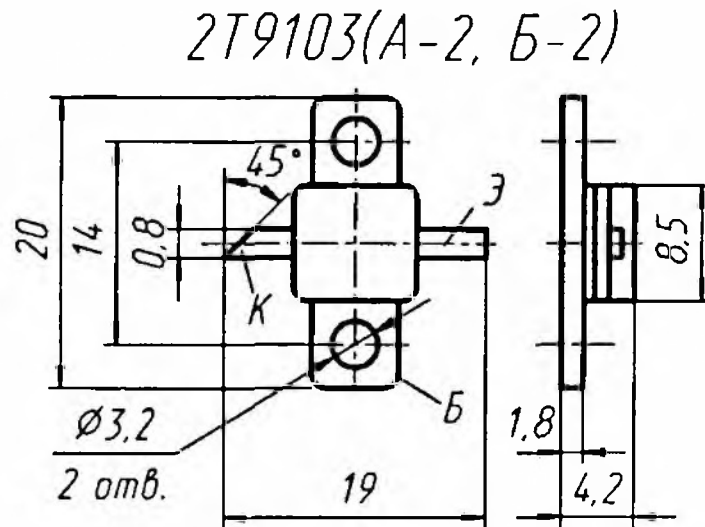


2Т9103А-2, 2Т9103Б-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ генераторные. Предназначены для применения в схеме с общей базой в усилителях, генераторах и умножителях в диапазоне частот 0,9...5 ГГц. Бескорпусные с полосковыми выводами на кристаллодержателе. Тип прибора указывается на крышке.

Масса транзистора не более 3 г.



Электрические параметры

Выходная мощность (медианное значение)

при $f = 5$ ГГц, $U_{кб} = 21$ В, $I_k = 0,9$ А, не менее:

$P_{вх} = 3,5$ Вт для 2Т9103А-2..... 7 Вт

$P_{вх} = 5$ Вт для 2Т9103Б-2..... 10 Вт

Выходная мощность 2Т9103А-2 при $f = 5$ ГГц,

$U_{кб} = 21$ В, $I_k = 0,9$ А 6...7*...8,5* Вт

Коэффициент усиления по мощности

2Т9103А-2 при $P_{вх} \leq 3,5$ Вт, $f = 5$ ГГц,

$U_{кб} = 21$ В, $I_k = 0,9$ А 1,72*...2*...2,4*

Коэффициент полезного действия коллекто-

ра 2Т9103А-2 при $P_{вх} \leq 3,5$ Вт, $f = 5$ ГГц,

$U_{кб} = 21$ В, $I_k = 0,9$ А 28...37*...45*%

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 25$ В,

не более:

$T = +25$ и -60 °С 7 мкА

$T = +125$ °С 70 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 2$ В,
не более:

$T = +25$ и -60 °С	0,5 мкА
$T = +125$ °С	3 мкА

Индуктивность выводов:

базового	0,04* нГн
коллекторного	0,2* нГн
эмиттерного	0,25* нГн

Предельные эксплуатационные данные

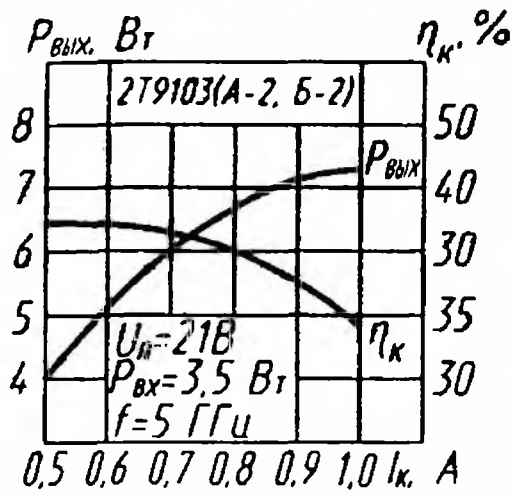
Постоянное напряжение коллектор—база.....	25 В
Постоянное напряжение эмиттер—база.....	2 В
Постоянный ток коллектора	1,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора	3 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме.....	16,4 Вт
Минимальная рабочая частота	0,9 ГГц
Напряжение питания в диапазоне частот:	
0,9...1,4 ГГц.....	15 В
1,4...2,5 ГГц.....	18 В
свыше 2,5 ГГц	21 В
Тепловое сопротивление переход—корпус	8,5 °С/Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+165 °С
Температура кристаллодержателя	+125 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_k =$ = +125 °С

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 2 мм от кристаллодержателя до места пайки при температуре не выше +260 °С в течение не более 3 с.

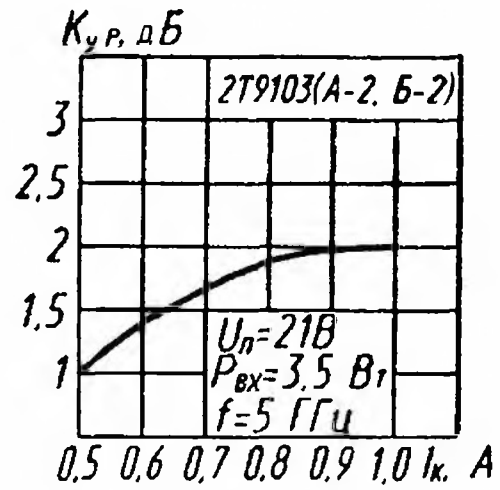
Допускается пайка выводов не ближе 0,5 мм от кристаллодержателя при температуре не выше +150 °С.

При монтаже транзисторов допускается обогреть выводы не ближе 1 мм от кристаллодержателя.

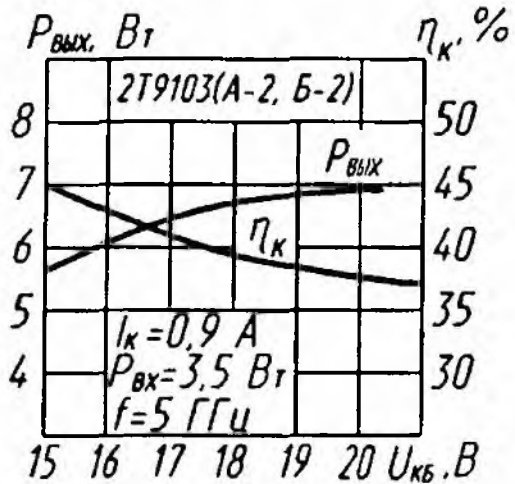
Допустимое значение статического потенциала 1000 В.



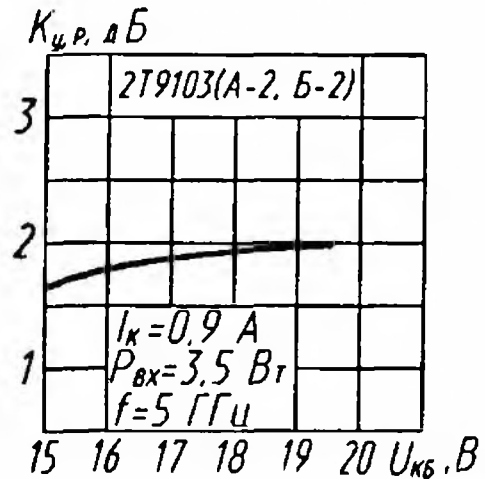
Зависимости выходной мощности и коэффициента полезного действия коллектора от тока коллектора



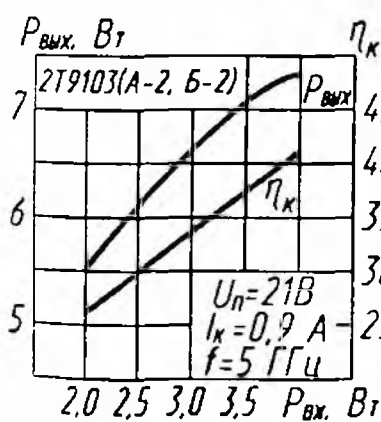
Зависимость коэффициента усиления по мощности от тока коллектора



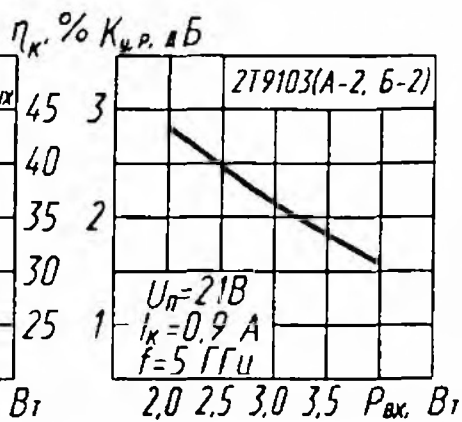
Зависимости выходной мощности и коэффициента полезного действия от напряжения коллектор—база



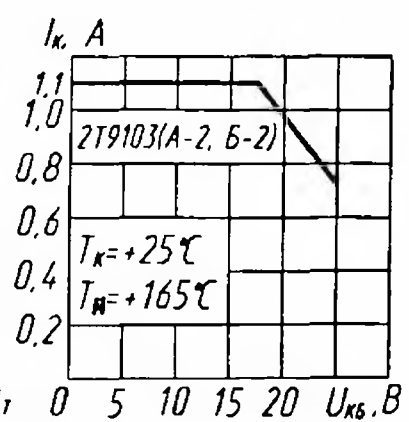
Зависимость коэффициента усиления по мощности от напряжения коллектор—база



Зависимости выходной мощности и коэффициента полезного действия от входной мощности



Зависимость коэффициента усиления по мощности от входной мощности



Область максимальных режимов